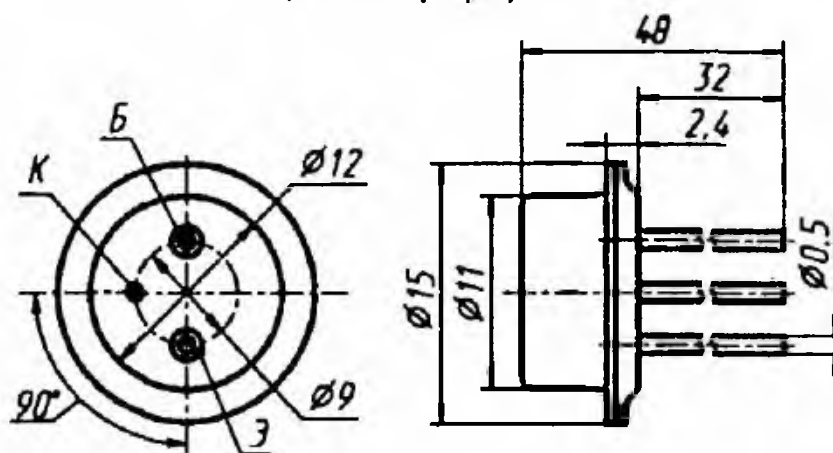


2Т602А, 2Т602Б, 2Т602АМ, 2Т602БМ, КТ602АМ, КТ602БМ

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n*. Предназначены для генерирования и усиления сигналов. Транзисторы 2Т602А, 2Т602Б выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами, 2Т602АМ, 2Т602БМ, КТ602АМ, КТ602БМ — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов 2Т602А, 2Т602Б, не более 5 г, 2Т602АМ, 2Т602БМ, КТ602АМ, КТ602БМ — не более 1 г.

2Т602(А,Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 10$ мА:

2Т602А, 2Т602АМ, КТ602АМ	20...80
2Т602Б, 2Т602БМ	50...200
КТ602БМ, не менее	50
2Т602А, 2Т602АМ при $T = -60$ °С, КТ602АМ при $T = -45$ °С	5...80
2Т602Б, 2Т602БМ при $T = -60$ °С	12...200
2Т602А, 2Т602АМ при $T = +125$ °С, КТ602АМ при $T = +85$ °С	50...500

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_К = 25$ мА,
не менее

150 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 50$ мА,
не менее

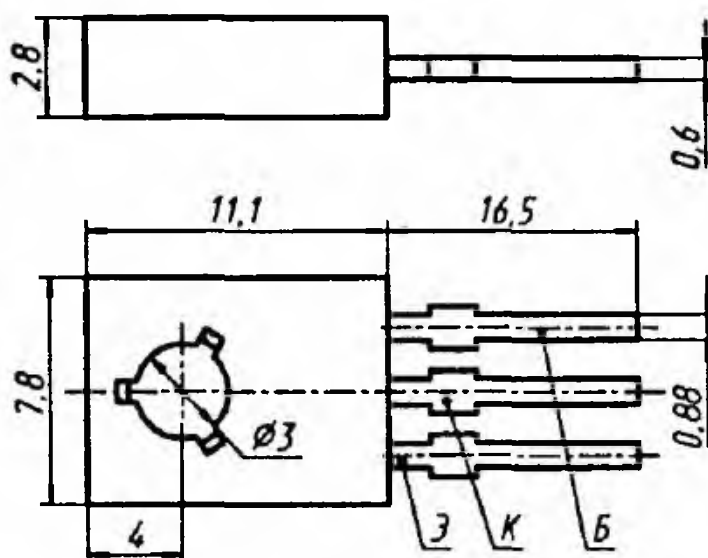
70 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_К = 50$ мА, $I_Б = 5$ мА, не более

3 В

2Т602(АМ,БМ)

КТ602(АМ,БМ)



Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_K = 50$ мА, $I_E = 5$ мА, не более 3 В

Постоянная времени цепи обратной связи на

высокой частоте при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 10$ мА,

$f = 2$ МГц, не более 300 пс

Емкость коллекторного перехода $U_{КБ0} = 50$ В,

не более 4 пФ

Емкость эмиттерного перехода $U_{КБ0} = 0$,

не более 25 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ0} = 120$ В,

не более:

2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ 10 мкА

КТ602АМ, КТ602БМ 70 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $U_{КЭ} = 100$ В, $R_{БЭ} = 10$ Ом, не более:

2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ 10 мкА

КТ602АМ, КТ602БМ 100 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 5$ В,

не более 50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ:

$T_n = +100$ °С 120 В

$T_n = +150$ °С 60 В

КТ602АМ, КТ602БМ:

$T_n \leq +70$ °С 120 В

$T_n = +120$ °С 60 В

Импульсное напряжение коллектор—база:

2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ:

$T_n = +100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 В

$T_n = +150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 80 В

КТ602АМ, КТ602БМ при $T_n = +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{бэ} = 1\text{ кОм}$:

2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ:

$T_n = +100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 100 В

$T_n = +150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 50 В

КТ602АМ, КТ602БМ:

$T_n \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 100 В

$T_n = +120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 50 В

Постоянное напряжение эмиттер—база 5 В

Постоянный ток коллектора 75 мА

Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 1\text{ мкс}$ 500 мА

Постоянный ток эмиттера 80 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

без теплоотвода:

$T \leq +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 0,85 Вт

$T = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$ для 2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ 0,16 Вт

$T = +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ для КТ602АМ, КТ602БМ 0,2 Вт

с теплоотводом:

$T \leq +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2,8 Вт

$T = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$ для 2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ 0,56 Вт

$T = +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ КТ602АМ, КТ602БМ 0,65 Вт

Тепловое сопротивление:

переход—корпус 45 $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$

переход—окружающая среда 150 $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$

Температура р-п перехода:

2Т602А, 2Т602АМ, 2Т602Б, 2Т602БМ +150 $^{\circ}\text{C}$

КТ602АМ, КТ602БМ +120 $^{\circ}\text{C}$

Температура окружающей среды -60...+125 $^{\circ}\text{C}$

Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм для 2Т602А, 2Т602Б. Для 2Т602АМ, 2Т602БМ, КТ602АМ, КТ602БМ допускается однократный изгиб при тех же условиях.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре не выше +260 $^{\circ}\text{C}$ в течение не более 10 с для 2Т602А, 2Т602Б, не более 3 с для 2Т602АМ, 2Т602БМ, КТ602АМ, КТ602БМ.